تأثیر ولتاژ و زمان رسوبنشانی الکتریکی بر خواص الکتروکرومیکی پوششهای WO3

پریسا کاظمیزاده^۱، مصطفی میرجلیلی^۲*، قاسم براتی دربند^۳

مواد الکتروکرومیک وقتی در میدان الکتریکی قرار می گیرند، تغییر رنگ میدهند و از مهمترین کاربردهای این مواد، میتوان به پنجرههای هوشمند اشاره کرد. این پنجرهها نقش مهمی در صرفه جویی مصرف انرژی و همچنین کنترل شرایط نوری و دمایی اتاق دارند. اکسید تنگستن به عنوان یک ماده الکتروکرومیک، به دلیل بازده رنگی الا توجه زیادی از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در مطالعه حاضر، ولتاژ و زمان بهینه جهت رسوبنشانی الکتریکی اکسید تنگستن به عنوان یک ماده الکتروکرومیک، به دلیل بازده رنگی و همچنین و جرمه زیادی از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. در مطالعه حاضر، ولتاژ و زمان بهینه جهت رسوبنشانی الکتریکی اکسید تنگستن مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایشهایی که بر اساس ویژگیهای نوری، ریزساختاری و چرخه ولتامتری انجام شد، نشان داد که ولتاژ کاتدی ۴۵۰ – میلیولت (نسبت به الکترود مرجع نقره/ نقره کلرید) و زمان رسوبنشانی ۳ دقیقه باعث بهبود ویژگیهای الکتروکرومیکی لایههای اکسید تنگستن در الکترولیت و زمان رسوبنشانی ۲ دقیقه باعث بهبود ویژگیهای الکتروکرومیکی لایههای اکسید تنگستن در الکترولیت و زمان رسوبنشانی تا دقیقه باعث بهبود ویژگیهای الکتروکرومیکی لایه مواد الای در الکترولیت می سولفوریک اسید یک مولار شده است. میزان بازده رنگی برای این لایه کاه می الکترود مرجع نقره/ نقره کلرید) مولفوریک اسید یک مولار شده است. میزان بازده رنگی برای این لایه ۲۰/۱۳ دست آمد و پایداری مولفوریک اسید یک مولار شده است. میزان بازده رنگی برای این لایه ۱۰/۱۳ دست آمد و پایداری مناسی یا ۱۰۰ جرخه از خود نشان داده است.

واژههای کلیدی: الکتروکرومیک، رسوبنشانی الکتریکی، اکسید تنگستن، شیشه ITO

حكىدە

Effect of Voltage and Time of Electrodeposition on the Electrocheromic Charactristics of WO₃

P. Kazemizadeh, M. Mirjalili, Gh. Barati Darband

Abstract

Electrochromic materials change color when placed in an electric field. Among their most important applications, we can mention electrochromic windows. These windows play an important role in saving energy as well as controlling the light and thermal conditions of the room. Tungsten oxide as an electrochromic material has attracted a lot of attention from researchers due to its high color efficiency. We studied the effect of voltage and time on the electrochromic properties to reach optimal conditions for tungsten oxide deposition using electrochemical

> ^۱ دانشجوی کارشناسیارشد- مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه فردوسی مشهد mirjalili@um.ac.ir ۲ نویسنده مسئول- استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه فردوسی مشهدmac.ir ۱ ستادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی- دانشگاه فردوسی مشهدbaratidarband@um.ac.ir

deposition method. Optical and microstructural investigations and cyclic voltammetry were performed and showed that the cathodic voltage of -450 mV (versus Ag/AgCl reference electrode) and the deposition time of 3 minutes has improved the electrochromic characteristics of tungsten oxide layers in one molar sulfuric acid electrolyte. The color efficiency for this layer was 12.16 cm^2/C and it has shown good stability up to 100 cycles.

۱. مقدمه

keywords: electrochromic, electrodeposition, tungsten oxide, ITO glass

تولد تکنولوژی الکتروکرومیسم به گزارش دب در سال ۱۹۷۳ برمی گردد که از آن زمان تلاشهای زیادی در توسعه یمواد الکتروکرومیک انجام شده است [۱, ۲]. مواد الکتروکرومیک موادی هستند که با اعمال میدان الکتریکی تغییر رنگ می دهند. پدیده الکتروکرومیسم در تعدادی از مواد آلی و معدنی مشاهده شده است؛ پلیمرهای رسانا و ویولوژنها را میتوان از مواد آلی الکتروکرومیک نام برد [۳, ۴]. میتوان گفت تمام مواد معدنی مورد نظر، همان طور که در جدول ۱ مشاهده می شود، اکسیدهایی هستند که به گروه عناصر واسطه تعلق دارند؛ بنابراین خاصیت الکتروکرومیسم وابستگی شدیدی به ساختار الکترونی مواد دارد [۷–۵]. مواد الکتروکرومیک معدنی دارای مزایایی مانند پایداری بهتر، وزن سبکتر و تولید آسانتر در مساحت بزرگ هستند [۸]. از این میان، اکسید تنگستن دارای راندمان رنگی بالا، زمان پاسخ سریع و پایداری شیمیایی و الکتروشیمیایی بالا می باشد [۹. ۱].

مرجع	درحالت کاهش	درحالت اکسایش	کاتدی/آندی	اکسید
[11]	آبی	شفاف	کاتدی	CeO ₂
[۵, ۶]	آبی	شفاف	كاتدى	WO ₃
[17]	آبى	شفاف	كاتدى	MoO ₃
[١٣]	شفاف	قهوهای/ مشکی	آندی	NiO
[14]	آبى	شفاف	كاتدى	TiO ₂
[18,10]	مشکی	شفاف	كاتدى	Ta ₂ O ₅
[\Y]	آبى	زرد	کاتدی/ آندی	V ₂ O ₅

جدول ۱. ویژگی مواد الکتروکرومیک معدنی مطالعه شده.

[١٨,٧]	قهوهای/ مشکی	شفاف	کاتدی	Nb ₂ O ₅
[١٩]	شفاف	نارنجى	آندی	MnO ₂
[7+]	قهوهای	آبی تیرہ	آندی	CoO ₂
[71]	شفاف	خاكسترى	آندی	IrO ₃
[77]	آبی	شفاف	کاتدی	ZnO

با توجه به فرآیند انتقال الکترون، مواد الکتروکرومیک به دو دسته کاتدی و آندی تقسیم میشوند. مواد کاتدی موادی هستند که با دریافت الکترون رنگی میشوند؛ در حالیکه در مواد آندی، رنگی شدن در اثر از دست دادن الکترون رخ میدهد [۳۳]. برخلاف شیشههای معمولی که نمیتوانند میزان عبور نور خورشید را تنظیم کنند، شیشههای الکتروکرومیک امکان تغییر میزان انتقال نور را با اعمال میدان الکتریکی کوچک فراهم میکنند. این قابلیت تغییر رنگ، در آینهها و نمایشگرهای هوشمند نیز مورد استفاده قرار میگیرد. قابلیت مات و شفاف شدن این پنجرهها علاوه بر کنترل انرژی دریافتی، در ایجاد فضایی امن به عنوان مثال در اتاق جلسات، سرویسهای بهداشتی و حمام حائز اهمیت است [۲۴].

روشهای مختلفی برای رسوبنشانی اکسید تنگستن وجود دارد که ازجمله آنها میتوان به روشهای هیدروترمال، سل-ژل، تبخیرحرارتی، کندوپاش و رسوبنشانی الکتریکی و ... اشاره کرد [۲۷-۲۵].

در میان روش های ایجاد لایه، رسوبنشانی الکتریکی یک روش خوب برای ساخت مواد نانوساختار گزارش شده است [۲۸]. در این روش، کنترل بالایی بر روی ضخامت و ساختار وجود دارد. بنابراین توزیع یکنواختی از ذرات و تخلخلها را خواهیم داشت. این روش، امکان رسوبنشانی در مقیاس بزرگ را فراهم می کند. علاوهبرآن، برخلاف روشهای رسوبنشانی فیزیکی (تبخیر، کندوپاش)، تحت فشار و دمای متعارفی قابل انجام است؛ بنابراین جزء روشهای کمهزینه محسوب می شود [۲۵, ۲۹, ۳۰]. جهت تشکیل لایهی اکسید تنگستن، درابتدا طبق واکنشهای ۲و۲ یونهای W₂O₁₁ در اثر حل شدن سدیم تنگستات در محلول آبی H₂O₂ تولید میشوند. سپس یونهای W₂O₁₁²⁻ به شکل H_xWO₃ آبیرنگ کاهش یافته و در نهایت H_xWO₃ آبی به اکسید تنگستن شفاف تبدیل می گردد.

$$2WO_{4^{2-}} + 4H_{2}O_{2} \rightarrow W_{2}O_{11^{2-}} + 2OH^{-} + 3H_{2}O$$
(1)

$$W_{2}O_{11^{2-}} + 10H^{+} + 8e^{-} \rightarrow 2WO_{3} + 5H_{2}O$$
(1)
(1)

در طول فرایند رسوبنشانی الکتریکی، اگرچه دافعه الکترواستاتیک بین سطح باردار منفی و یونهای منفی وجود دارد، اما باعث نفوذ یونها به سطح می شود که ضخامت لایه نفوذی با زمان افزایش پیدا می کند [۳۱, ۳۲].

ولتاژ و زمان مورد نیاز جهت رسوبنشانی، تأثیر زیادی بر روی شفافیت لایهها و خواص الکتروکرومیک آنها دارد. درواقع، اگر ولتاژ رسوبنشانی کم باشد، منجر به خواص الکتروکرومیک ضعیف خواهدشد و ولتاژ رسوبنشانی زیاد نیز باعث میشود که شفافیت لایهها تحت تاثیر قرار گیرد و رنگ لایهها قهوهای شود. همچنین با افزایش زمان رسوبنشانی، به دلیل تراکم مواد رسوبنشانی شده، روی شفافیت لایهها اثرگذار است [۶, ۳۳].

پارامتری مهم برای مقایسه خواص لایه های الکتروکرومیک، بازده رنگی (CE) است که به آن بازده الکتروکرومیک نیز می گویند و بایستی در طول موج ثابت و مشخص تعیین شود. واحد بازده رنگی cm²/C است که به صورت معادله (۲-۲) تعریف می شود.

(۴)

CE (λ) = η = Δ OD (λ) /q

چگالی نوری '(ΔOD) معیاری از میزان عبور نور در طول موج خاصی است که با معادله (۳-۲) بیان می شود.

^r Colored

[\] Optical Density

^r Bleached

و تهیه شده از شرکت پارس الکل به pH برابر با ۰٫۸ رسانده شده و درنهایت محلول پرکسوتنگستیک اسید (PTA) (حاصله به مدت ۱۵دقیقه در دمای ۲۰°۶۰ حرارت داده شد تا محلول همگن و شفافی حاصل گردد.

برای انجام رسوبنشانی WO3 ابتدا زیرلایههای (FTO)^۲ با مقاومت Δ / Δ / ۲ تهیه شده از شر کت نانو بازار را جهت حذف آلودگیهای احتمالی به مدت ۵ ادقیقه در حمام اولتراسونیک داخل اتانول با خلوص ۹۶٪ قرار داده شد و سپس در الکترولیت تهیه شده، تحت شرایط پتانسیل کاتـدی ثابـت در دمـای اتـاق قـرار گرفته شد. جهت انجام آزمون ولتامتری روبش خطی(LSV)^۳ از دستگاه پتانسیواستات ACM (Gill AC Instrument) ساخت کشور آزمون ولتامتری روبش خطی(LSV)^۳ از دستگاه پتانسیواستات ACM (Gill AC Instrument) ساخت کشور مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نمودار ولتامتری روبش خطی در شکل ۱۰، پتانسیلهای ۳۰۰- میلیولت و ۴۵۰- میلیولت و ۴۵۰- میلیولت در دو زمان رسوبنشانی ۳ و ۵ دقیقه و نیز پتانسیلهای ۲۵۰- میلیولت، ۴۰۰- میلیولت، ۴۰۰- میلیولت و ۴۵۰- میلیولت در زمان ۳ دقیقه انتخاب شدند. از پتانسیل ۵۰۰- میلیولت به بعد، جریان ناشی از تصاعد هیدروژن را میلیولت در زمان ۳ دقیقه انتخاب شدند. از پتانسیل ۵۰۰- میلیولت به بعد، جریان ناشی از تصاعد هیدروژن را میلیولت در زمان ۳ دقیقه انتخاب شدند. از پتانسیل ۵۰۰- میلیولت به بعد، جریان ناشی از تصاعد هیدروژن را میلی در خواهیم داشت.

¹ Peroxo Tungstic Acid

^r Folour Tin Oxide

^r Linear Sweep Voltammetry





شکل ۲. تصویری از شیشه رسوبنشانی شده با فیلم اکسید تنگستن در حین فرایند رسوبنشانی.

در انتها فیلمهای رسوبنشانی شده را در آب مقطر فرو برده و به مدت ۲۴ساعت در معرض هوای محیط قرار گرفتند. دمای محلولها نیز همواره در بازهی دمای محیط (C° T±۲) بوده است.

ریزساختار سطح نمونه با استفاده ازدستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی^۱ (FESEM) مدل ۱۸۰۰ مدل ۱۸۰۰ مدل ۱۸۰۰ مدل ۱۸۰۰ مدل ۱۸۰۰ مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه اسپکتروفوتومتری INO-Mira3 LMU مدل ۱۸۰۰ -- Shimadzu UV جهت بررسی خواص نوری نمونه ها استفاده شد. خاصیت الکتروکرومیک نمونه ها با انجام آزمون ولتامتری چرخه ای و آزمون پتانسیواستاتیک^۲ با استفاده از دستگاه پتانسیواستات^۳ مدل (ACM) و با استفاده از پیل الکتروشیمیایی سه الکترودی در محلول اسیدسولفوریک (H2SO4) خریداری شده از شرکت پارس الکل با خلوص ۹۷/۵٪ و با غلظت ۱ مولار، مورد بررسی قرار گرفت. از الکترود نقره/ نقره کلرید به عنوان الکترود مرجع استفاده شد و صفحه پلاتینی به عنوان الکترود کمکی مورد استفاده قرار گرفت.

^r Potentiostat

¹ Field Emission Scaning Electron Microscope

^r Potentiostatic

۳. بحث و نتیجه گیری

همان طور که در معادلهی (۳) می بینید، واکنش مورد نظر برای الکتروکرومیسم اکسید تنگستن به فرم ساده ذیل نمایش داده شده است:

(۳) $WO_3 + xM^+ + xe^- \leftrightarrow M_xWO_3(i_{n,0})$

در این معادله +M میتواند یونهای هیدروژن یا لیتیم باشد.

اگرکاتیونها اندازهی کوچکی داشته باشند، میزان نفوذ افزایش مییابد که این موضوع روی تغییرات نوری لایهها اثرگذار میباشد. همچنین انبساط و انقباضهای شبکه در هنگام ورود و خروج کاتیونها برگشتپذیر خواهد بود؛ در نتیجه ساختار اصلی فیلم حفظ میشود [۳۴, ۳۵].

۱٫۳. نتایج مطالعهی ریزساختاری سطح لایهها

و Error! Reference source not found.حاصل از نمونهها در

یکنواخت اعمال شده است. واضح شکل ۲ نشان داده شده است. همان طور که مشخص است پوشش به صورت

است با توجه به

شکل ۲ با افزایش ولتاژ، میزان تراکم ذرات و تخلخلها بیشتر می شود. این تراکمها باعث ایجاد شکاف و ترک شده است. کونگ و همکارانش نیز بیشتر شدن شکاف را با افزایش مقدار ولتاژ مشاهده کردند [۲۶]. در پژوهشی دیگر عنوان شده است که حضور شکافها باعث افزایش میزان مبادلهی بار و به دنبال آن میزان رنگی شدن لایهها در حالت اعمال ولتاژ می شود [۳۶].

-





شکل ۳. تصاویر FESEM لایههای نازک اکسید تنگستن در بزرگنمایی ۵۰ میکرومتر با ولتاژهای کاتدی و زمانهای رسوبنشانی مختلف: الف) ۳۰۰ میلیولت، ۳ دقیقه ب) ۳۰۰ میلیولت، ۵ دقیقه پ) ۳۵۰ میلیولت، ۳ دقیقه ت) ۴۰۰ میلیولت، ۳ دقیقه ث)





شکل ۲. تصاویر FESEM لایههای نازک اکسید تنگستن در بزرگنمایی ۵۰۰ نانومتر با ولتاژهای کاتدی و زمانهای رسوبنشانی مختلف: الف) ۳۰۰ میلیولت، ۳ دقیقه ب) ۳۰۰ میلیولت، ۵ دقیقه پ) ۳۵۰ میلیولت،۳ دقیقه ت) ۴۰۰ میلیولت، ۳ دقیقه ث)

۱٬۱٫۳ بررسی ویژگیهای الکتروکرومیکی لایهها با استفاده از منحنی ولتامتری چرخهای (CV)^۱ شکل ۳ نتایج آزمون ولتامتری چرخهای را در محلول الکترولیت ۱ مولار سولفوریک اسید (H₂SO4) برای فیلمهای اکسید تنگستن بهدست آمده نشان میدهد.

مساحت کل چرخه ولتامتری، تعیین کننده مقدار بار مبادله شده بین لایهها (ظرفیت بار) میباشد و هرچه مساحت CV افزایش پیدا کند، مقدار بار مبادله شده افزایش و در نتیجه بازده رنگی کاهش مییابد [۳۸, ۳۸]. با توجه به شکل ۵ میتوان دریافت که با افزایش ولتاژ رسوبنشانی از ۳۰۰- میلیولت تا ۴۵۰- میلیولت، مساحت منحنی CV افزایش یافته است. نمونه تهیه شده با ولتاژ رسوبنشانی از ۲۰۰- میلیولت در زمان رسوبنشانی ۳ دقیقه، پیک چگالی جریان CV افزایش یافته است. نمونه تهیه شده با ولتاژ ۹۰۰- میلیولت در زمان رسوبنشانی ۳ دقیقه، پیک چگالی جریان کوچکتری نشان میدهد.



۱۰ شکل ۳. نمودار چرخهی ولتامتری نمونههای پوشش داده شده با اکسید تنگستن در ولتاژها و زمانهای مختلف. نرخ روبش ۱۰ میلیولت بر ثانیه انتخاب شده است و محلول الکترولیت ۱ مولار اسید سولفوریک میباشد.

[\] Cyclic Voltagram

۲٫۱٫۳ بررسی زمان پاسخ لایه ها با استفاده از روش کرنو آمپرومتری(CA)^۱ میلی ولت به مدت ۳۰ ثانیه در الکترولیت ۱ مولار منحنی های کرنو آمپرومتری با اعمال ولتاژهای ۶۰۰ و ۱۰۰۰ میلی ولت به مدت ۳۰ ثانیه در الکترولیت ۱ مولار H2SO4 در شکل ۴ رسم شده است. زمان مورد نیاز برای فرایند رنگی و بی رنگ شدن لایه های تشکیل شده تحت شرایط مختلف رسوب نشانی از منحنی های کرونو آمپرومتری به دست آمده است.



شکل ۴. منحنی کرونوآمپرومتری لایهها در محلول الکترولیت ۱ مولار اسید سولفوریک در پتانسیلهای اعمالی ۶۰۰- و ۱۰۰۰ میلیولت برای زمان ۳۰ ثانیه.

زمان مورد نیاز برای فرایند رنگی و بی رنگ شدن لایههای اکسید تنگستن تشکیل شده تحت ولتاژهای کاتدی و زمانهای رسوبنشانی مختلف، در جدول ۲ آورده شده است.

¹ Chrono Amperometry

۴۵۰- میلیولت، ۳ دقیقه	۴۰۰- میلیولت، ۳ دقیقه	۳۵۰ – میلیولت، ۳ دقیقه	۳۰۰- میلیولت، ۵ دقیقه	۳۰۰- میلیولت، ۳ دقیقه	شرايط
					رسوبنشانی
$\Delta_{/}\Delta$ S	٩s	14 s	ta s	۴s	زمان رنگی شدن
۴s	$\mathcal{F}_{I}\Delta$ S	۴s	۴s	T S	زمان بیرنگ شدن

جدول ۲. زمان مورد نیاز برای فرایند رنگی و بیرنگ شدن لایههای اکسید تنگستن تشکیل شده تحت شرایط مختلف.

از جدول فوق مشاهده می کنیم که بهترین پاسخ زمانی مربوط به لایه های ۳۰۰ میلیولت و ۳ دقیقه و ۴۵۰ میلیولت و ۴۵۰ میلیولت و ۴۵۰ میلیولت و ۴۵۰ میلیولت و ۳۰ میلیولت و ۳۰۰ میاز جدول فوق مشاهده می کنیم که بهترین پاسخ زمانی مربوط به لایه های ۳۰۰ میلیولت و ۳ دقیقه و ۴۵۰ میلیولت و ۳۰۰ میلیولت و

۳٫۱٫۳ بررسی خواص نوری لایه ها با استفاده از طیف عبور نوری از دستگاه اسپکتروفوتومتری UV.VIS، طیف عبوری نمونه ها به دست آورده شد که در شکل ۵ ارائه گردیده است. با توجه به شکل ۵ می توان دریافت که با افزایش پتانسیل رسوب شانی از ۳۰۰ – میلی ولت تا ۴۵۰ – میلی ولت، کنتر است نوری لایه ها افزایش یافته است. این کنتر است نوری بالا با توجه به گزارش بابر و همکاران هی تواند نشانگر کیفیت بلوری نسبتا بالای لایه ها باشد [۳۹]. ریز ساختار نمونه ها بیانگر این مطلب بود که با افزایش ولتاژ، ترا کم پوشش در سطح نمونه افزایش یافته است. همچنین با افزایش زمان رسوب نشانی برای نمونه ۲۰۰۰ – میلی ولت حالت اعمال ولتاژ نیز افزایش یافته است. همچنین با افزایش زمان رسوب نشانی برای نمونه ۳۰۰ – میلی ولت از ۳۰ دقیقه به ۵ دقیقه، کنتر است نوری کاهش یافته است.



شکل ۵. قابلیت عبور برای لایههای رسوبنشانی شده در ولتاژهای کاتدی مختلف در دو حالت رنگی و بیرنگ، در بازهٔ طول موجی۳۰۰ تا۹۰۰ نانومتر. نمونههای بیرنگ در پتانسیل ۶۰۰ میلیولت به مدت ۶۰ ثانیه و نمونههای رنگی در پتانسیل ۶۰۰-میلیولت به مدت ۶۰ ثانیه نگه داشته شدهاند. محلول الکترولیت ۱ مولار اسید سولفوریک بوده است.

میزان کنتراست نوری، چگالی نوری و بازده رنگی در طول موج ۶۳۲٬۸ نانومتر برای نمونههای رسوبنشانی شده

با شرایط رسوبنشانی متفاوت، در جدول ۳ آورده شده است.

۴۵۰ – میلیولت، ۳ دقیقه	۴۰۰ – میلیولت، ۳ دقیقه	۳۵۰- میلیولت، ۳ دقیقه	۳۰۰ – میلیولت، ۵ دقیقه	۳۰۰ – میلیولت، ۳ دقیقه	شرايط
					رسوبنشانی
<i></i>	∕.Δ•	۲.۲X/	<u>٪</u> ۱۴	7.10	АТ
۰٫۳۵	۰٫۳۵	•,1۴	• , • Y	• • • •	ΔΟD
17,18	٩ _/ ٩٧	۴,•۶	· , λ ۶	٩,۴۵	CE (cm ² /C)

جدول ۳. میزان کنتراست نوری، چگالی نوری و بازده رنگی در طول موج ۶۳۲/۸ نانومتر برای نمونههای رسوبنشانی شده در شرایط مختلف.

از جدول ۳ مشاهده می کنیم که بهترین بازده رنگی مربوط به لایهای است که به مدت ۳دقیقه تحت ولتاژ ۴۵۰-میلیولت رسوبنشانی شدهاست.

۴٫۱٫۳. بررسی پایداری الکتروشیمیایی لایهها با استفاده از روش ولتامتری چرخهای

به منظور ارزیابی پایداری پوشش، منحنی های CV برای چرخه ی ۱ و ۱۰۰ در دمای اتاق با نرخ روبش ۱۰۰ میلی ولت بر ثانیه گزارش شده است. با احیا اکسید تنگستن، رنگ آن به آبی تغییر می کند. این واکنش برگشت پذیر است، بنابراین پیک جریان اکسیداسیون، هنگامی که ولتاژ بصورت مثبت روبش می شود، مشاهده شده و WO3 به حالت بی رنگ خود بازمی گردد. باتوجه به شکل ۶ مشاهده می کنیم که لایه ی اکسید تنگستن تشکیل شده در ولتاژ ۴۵۰– میلی ولت و زمان ۳ دقیقه پایداری خوبی از خود نشان داده است.



شکل ۶. نمودار چرخه ولتامتری برای مقایسه چرخه اول و صدم لایههای اکسید تنگستن رسوبنشانی شده تحت شرایط پتانسیل کاتدی و زمانهای مختلف. الف) ۳۰۰ میلیولت، ۳ دقیقه ب) ۳۰۰ میلیولت، ۵ دقیقه پ) ۳۵۰ میلیولت،۳ دقیقه ت) ۴۰۰ میلیولت، ۳ دقیقه ث) ۴۵۰ میلیولت، ۳ دقیقه. نرخ روبش در این نمودارها ۱۰۰ میلیولت بر ثانیه بوده است.

روش رسوبنشانی الکتریکی، جهت تهیه پوشش الکتروکرومیک اکسید تنگستن بر روی زیرلایه FTO استفاده شد. انتخاب ولتاژ و زمان رسوبنشانی مناسب، تاثیر زیادی برروی کیفیت و شفافیت لایهها و همچنین خواص الکتروکرومیک آنها داشت. بررسیهای الکتروشیمیایی و ریزساختاری جهت انتخاب بهترین ولتاژ و زمان لایهنشانی نشان داد که ولتاژ کاتدی ۴۵۰ میلیولت و زمان ۳ دقیقه بالاترین بازده رنگی را دارد. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط بالا، پایداری پوشش تا ۱۰۰ سیکل مناسب بوده است.

مراجع

- [1] Y. Nishikitani, T. Asano, S. Uchida, and T. Kubo, "Thermal and optical behavior of electrochromic windows fabricated with carbon-based counterelectrode," Electrochimica .Acta, vol. 55, no. 14, pp. 7711-77117, 1999
- [Y] M. Green and D. Richman, "A solid state electrochromic cell—the RbAg^²I^o/WO^{^w} .system," Thin Solid Films, vol. Y^² no. Yⁱ pp. S^²O⁻S^² N¹Y²
- [^r] S. H. Lee et al., "Crystalline WO" nanoparticles for highly improved electrochromic .applications," Advanced Materials, vol. 14 no. 3 pp. V3T-V33 r · · 3
- [٤] R. J. Mortimer, "Electrochromic materials," Annual review of materials research, vol. ει. .pp. Υει-Υ٦Λ. Υ·ΙΙ
- [°] G. Zhang et al., "Physical simulation model of WO" electrochromic films based on continuous electron-transfer kinetics and experimental verification," ACS Applied .Materials & Interfaces, vol. 1", no. ", pp. ٤٧٦٨-٤٧٧٦, ٢, ٢)
- [7] L. Jia, W. Ma, Q. Zhuang, Y. Zhang, and J. Dang, "Controllable Electrodeposition Adjusts the Electrochromic Properties of Co and Mo Co-Modified WO" Films," Crystals, vol. 176 .no. 76 p. 1966707
- [^V] D. Calloway, "Beer-lambert law," Journal of Chemical Education, vol. V£: no. V: p. V££: . 199V
- [A] A. Azens, L. Kullman, G. Vaivars, H. Nordborg, and C. Granqvist, "Sputter-deposited nickel oxide for electrochromic applications," Solid State Ionics, vol. 117, pp. 229-207, 199A
- [9] S. Y. Kim, T. Y. Yun, K. S. Yu, and H. C. Moon, "Reliable, high-performance electrochromic supercapacitors based on metal-doped nickel oxide," ACS Applied .Materials & Interfaces, vol. 17, no. 57, pp. 019VA-019A7, 7, 7,
- [1.] M. Rao, "Structure and properties of WO^T thin films for electrochromic device .application," J. Non-Oxide Glasses, vol. °, pp. 1-A, 7, 17

- [17] F. Decker, S. Passerini, R. Pileggi, and B. Scrosati, "The electrochromic process in nonstoichiometric nickel oxide thin film electrodes," Electrochimica Acta, vol. "V, no. ", pp. .1997, J. TA-J. TT
- [17] X. Xia, J. Tu, J. Zhang, X. Wang, W. Zhang, and H. Huang, "Electrochromic properties of porous NiO thin films prepared by a chemical bath deposition," Solar Energy Materials .and Solar Cells, vol. 97 no. 3 pp. 37A-3777, 7 . . A
- [12] F. Campus, P. Bonhote, M. Grätzel, S. Heinen, and L. Walder, "Electrochromic devices based on surface-modified nanocrystalline TiO⁷ thin-film electrodes," Solar Energy .Materials and Solar Cells, vol. °¹ (no. ^r-²) (pp. ^rA)-^r9^v (1999)
- [17] F. Z. Tepehan, F. E. Ghodsi, N. Ozer, and G. G. Tepehan, "Optical properties of sol-gel dip-coated Ta^YO^o films for electrochromic applications," Solar energy materials and solar .cells, vol. ^{oq} no. ^T pp. ^YI^o-^YV^o 1999
- [1V] Y. Lu, L. Liu, D. Mandler, and P. S. Lee, "High switching speed and coloration efficiency of titanium-doped vanadium oxide thin film electrochromic devices," Journal of Materials .Chemistry C, vol. 1, no. 55, pp. YTA--YTAT, 7, 17
- [1^] R. Romero, E. Dalchiele, F. Martín, D. Leinen, and J. Ramos-Barrado, "Electrochromic behaviour of Nb^YO^o thin films with different morphologies obtained by spray pyrolysis," .Solar Energy Materials and Solar Cells, vol. ⁹7, no. ^Y, pp. ^{YYY}-^{YY9}, ^{YYY}-^{YY9}
- [19] N. Sakai, Y. Ebina, K. Takada, and T. Sasaki, "Electrochromic films composed of MnO^Y nanosheets with controlled optical density and high coloration efficiency," Journal of the .Electrochemical Society, vol. 1°Y, p. E^{YAE, Y++°}
- [^{*}] C. R. Dhas, R. Venkatesh, R. Sivakumar, A. M. E. Raj, and C. Sanjeeviraja, "Effect of solution molarity on optical dispersion energy parameters and electrochromic performance of Co[°]O^² films," Optical Materials, vol. ^V^{*} pp. ^V)^V-^V^{*}9, ^{*} · ^V
- [^Y] J. McIntyre, W. Peck, and S. Nakahara, "Oxidation state changes and structure of electrochromic iridium oxide films," Journal of The Electrochemical Society, vol. 1996, no. 7, p. 1975, 1986.
- [^Y^T] G. Cai, A. L. S. Eh, L. Ji, and P. S. Lee, "Recent advances in electrochromic smart .fenestration," Advanced Sustainable Systems, vol. 1. no. 17. p. 17...72. 7.17
- [¹^٤] P. Yang, P. Sun, and W. Mai, "Electrochromic energy storage devices," Materials today, .vol. 19, no. V, pp. "9٤-٤, ٢, ٢, ١٦
- [^{Yo}] G. Mineo, F. Ruffino, S. Mirabella, and E. Bruno, "Investigation of WO^r electrodeposition .leading to nanostructured thin films," Nanomaterials, vol. 1.400, A. p. 1297, 7.7.
- [⁷⁷] W. Kwong, H. Qiu, A. Nakaruk, P. Koshy, and C. Sorrell, "Photoelectrochemical properties of WO" thin films prepared by electrodeposition," Energy Procedia, vol. ⁷² .pp. 1)V-177, 7.17

- [^γ^γ] K. Ç. Demir, "Corrosion behavior of electrodeposited WO[°] thin films," Ceramics .International, vol. ^ε^γ, no. ^ε^γ, pp. ^{ε^γ}^οΛ₋^{ε^γ^γ^ε^γ, ^γ^γ, ^{ε^γ}}
- [^үA] X. Li et al., "Enhanced Electrochromic Properties of Nanostructured WO^{^w} Film by .Combination of Chemical and Physical Methods," Coatings, vol. 11, no. ^A, p. 909, 7, 71
- [^{Y4}] Z. Yu, X. Jia, J. Du, and J. Zhang, "Electrochromic WO" films prepared by a new electrodeposition method," Solar energy materials and solar cells, vol. ¹[¢], no. ¹[¢], pp. ^{oo}-.^Y, ¹[°], ¹[°]
- [^r•] X.-b. Li and G.-r. Xu, "Hydrothermal vs electrodeposition: How does deposition method affect the electrochemical capacitor performance of manganese dioxide?," Ceramics .International, vol. [£]^r• no. ¹^r• pp. ^{A9}¹^r• ^{A9}¹^g• ^{*}• ¹^v</sup>
- [^r] V. H. V. Quy, I.-R. Jo, S.-H. Kang, and K.-S. Ahn, "Amorphous-crystalline dual phase WO^r synthesized by pulsed-voltage electrodeposition and its application to electrochromic devices," Journal of Industrial and Engineering Chemistry, vol. ⁹[£], pp. .^x, ^x), ^x).^x
- [^٣Y] Y. O. Kim, S.-H. Yu, K.-S. Ahn, S. K. Lee, and S. H. Kang, "Enhancing the photoresponse of electrodeposited WO" film: Structure and thickness effect," Journal of Electroanalytical .Chemistry, vol. ^{Yo}Y, pp. ^{Yo}-^۳Y, ^Y, ^{Yo}
- [""] M. Deepa, A. Srivastava, S. Singh, and S. Agnihotry, "Structure-property correlation of nanostructured WO" thin films produced by electrodeposition," Journal of materials .research, vol. 19, no. 9, pp. Yoy7-YoAo, Y...
- [^r^ε] V. R. Buch, A. K. Chawla, and S. K. Rawal, "Review on electrochromic property for WO" thin films using different deposition techniques," Materials Today: Proceedings, vol. " .no. 3, pp. 1279-1279, 7,13
- [^{ro}] M. Hepel, "Electrochromic WO" films: Nanotechnology experiments in instrumental analysis and physical chemistry laboratories," Journal of chemical education, vol. ^{Ao} no. .p. ¹^{ro}, ^r^{ro}, ¹^{so}, ¹^{ro}, ¹^{so}, ¹^{so}
- [⁷⁷] G. Leftheriotis and P. Yianoulis, "Development of electrodeposited WO" films with modified surface morphology and improved electrochromic properties," Solid State Ionics, .vol. 1994, no. 74, pp. 7197-7199, 744
- [^{*v]} A. Kumar, C. S. Prajapati, and P. Sahay, "Modification in the microstructural and electrochromic properties of spray-pyrolysed WO" thin films upon Mo doping," Journal .of Sol-Gel Science and Technology, vol. 9., no. 7, pp. 741-790, 7.19
- [^m] V. S. Kumbhar et al., "Electrochromic and pseudocapacitive behavior of hydrothermally .grown WO^m nanostructures," Thin Solid Films, vol. V. 9, p. 1^mAT12, T.T.
- [^{٣٩}] A. Babar, P. Deshamukh, R. Deokate, D. Haranath, C. Bhosale, and K. Rajpure, "Gallium doping in transparent conductive ZnO thin films prepared by chemical spray pyrolysis," *Journal of Physics D: Applied Physics*, vol. 41, no. 13, p. 135404, 2008.